

☀ 今日的重要事項

電流 → 単位時間あたりの電荷の流れ 単位 : A (アンペア) 1A = 1C/1sec
 定常電流 : 時間的に変化しない電流
 電流密度 : 単位面積あたりの電流
 キルヒホッフの第 1 法則 : $\sum_i j_i = 0$

☀ 小テストおよびその解答

半径 a の導体球の表面に正の電荷 Q が一様に分布している。

a) 電場の様子を描け。

(略)

b) ガウスの法則を書け。

$$\int_S E(r) dS = \frac{1}{\epsilon_0} (\text{S内の総電荷})$$

c) 導体球の内部の電場の大きさを求めよ。

ガウスの法則を適用する閉曲面 S として、導体球と同じ中心をもつ半径 r の球面を考える。

電荷は導体球面上に存在するので、導体球の内部 ($r < a$) では、閉曲面 S 内には電荷は無い。したがって、 $r < a$ では、 $E(r) = 0$

d) 導体球の中心からの距離を r として、球の外部の電場の大きさ $E(r)$ を求めよ。

ガウスの法則の法則を適用する半径 r の球面上では、電場は垂直でその大きさは一定なので、ガウスの法則の左辺の面積分は

$$\int_S E_n dS = E(r) \times (\text{半径 } r \text{ の球面の面積}) = 4\pi r^2 E(r)$$

一方、右辺の S 内の総電荷は Q なので、

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

となる。

e) 導体球の中心からの距離を r として、電位 $\varphi(r)$ を求めよ。

電位の基準点を無限遠方 ($r = \infty$) とすると、導体球の外部 ($r > a$) では、

$$\varphi(r) = -\int_{\infty}^r E(r) dr = -\int_{\infty}^r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \left[\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_{\infty}^r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

となる。一方、導体球の内部 ($r < a$) では、電場がゼロなので、

$$\varphi(r) = -\int_{\infty}^r E(r) dr = -\int_{\infty}^a \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr - \int_a^r 0 dr = \left[\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_{\infty}^a = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

となる。

☀ 宿題

ガウスの法則を使って、いろいろな場合の電場、電位を求められるようにしておいて下さい。

- ・ 球
- ・ 直線、円筒
- ・ 平面